

保有技術一覧

ダイシング

項目	量産実績		備考
対応ウエハ材料	Si / GaAs		【試作対応実績】 SiGe / InGaP / InGaAs 【分離方式】 ・ブレードダイシング方式 ・スクライブ方式
対応ウエハサイズ	Si	max: ϕ 8inch	
	GaAs	max: ϕ 6inch	
チップサイズ	Si	[X-Y]	
		[Thick]	
	GaAs	[X-Y]	
		[Thick]	
ダイシングライン幅	40 μ m		

ダイボンド

項目	量産実績		備考
チップ接合材	導電樹脂 / 非導電樹脂 / はんだ		Multi chip mount : Stack , Side by Side 【試作対応実績】 □0.15mm~
実装対応サイズ	[X-Y]	0.232mm~7.2mm	
	[Thick]	0.075mm~0.68mm	

フリップチップ

項目	量産実績		備考
はんだボール	ピッチ	215 μm ~ 540 μm	【試作対応実績】基板厚み：0.03mm～ ・装置スペック上、基板厚み3mmまで対応可能 （キャリアを含む）
	ボール径	ϕ 125 μm ~ ϕ 300 μm	
	ボール厚	100 μm ~ 150 μm	
対応基板厚み	163 μm ~ 300 μm		UBM及びはんだボール搭載可能(外注委託)

ワイヤボンド

項目	量産実績		備考
線材	Au / Al		
線径	Au	$\phi 18.0\mu\text{m} \sim \phi 30\mu\text{m}$	
	Al	$\phi 100\mu\text{m} \sim \phi 500\mu\text{m}$	
最小パッドピッチ	55 μm		
最低ループ高さ	75 μm		

部品実装

項目	量産実績		備考
部品サイズ	～0402（N2リフロー） / 各種異形部品		※フレキシブル基板対応可能
ランド間隔	150μm		
接合材(はんだ)	Sn-Ag-Cu		
対応基板厚み	PCB	0.2mm～1.0mm	
	LTCC	0.3mm～0.7mm	

封止

項目	量産実績		備考
封止方式	トランスファーモールド / 真空印刷封止 / CAP（樹脂・金属）		【対応モールド厚み（T/F）】 0.7mm/0.6mm/0.4mm/0.2mm
対応基板	T/F	リードフレーム / PCB	
	印刷	LTCC	

パッケージ分離(個片化)

項目	量産実績			備考
対応PKG材料	Cuフレーム / PCB / LTCC / HTCC			【試作対応実績】
PKGサイズ	Cuフレーム	[X-Y]	1.5mm~12.0mm	・石英 / 真鍮 【分離方式】 ・ブレードダイシング方式
	+	[Thick]	0.36mm~0.9mm	
	モールド			
	ガラエポ	[X-Y]	3.0mm~14.0mm	
	+	[Thick]	0.4mm~2.5mm	
	モールド			
	LTCC	[X-Y]	2.2mm~15.0mm	
		[Thick]	0.91mm~1.7mm	
	LTCC	[X-Y]	2.0mm~5.0mm	
	+	[Thick]	0.5mm~1.6mm	
	モールド			
	HTCC	[X-Y]	1.2mm~9.0mm	
		[Thick]	1.2mm	
ブレード幅	0.15mm~0.5mm			

テスト

項目	量産実績	備考
周波数帯域	50MHz ～ 20GHz	計測システムの構築からテストプログラム作成まで対応
耐圧（電源）	80V（0.5A） / 20V（2A）	
機能（測定）	RFパワー / P1dB / 高調波歪み / ACP / NF / Sパラ/RL/EVM	